

а 2020 0054

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к фотоприемникам инфракрасного излучения. Фотоприемник инфракрасного излучения включает нанонить GaAs и металлические контакты. При этом, нанонить изготовлена путем анодирования пластины GaAs, а на концах нанонити сформированы омические контакты Cr/Au путем осаждения с применением литографии лазерным пучком.

П. формулы: 1

Фиг.: 4